
	<h2>NTJS3157NT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTJS3157NT1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTJS3157NT1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 209933 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTJS3157NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	209933 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTJS3157NT1G ist neu im Original, Suche NTJS3157NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJS3157NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJS3157NT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTJS4151PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS3151PT2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 2.7A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS3151PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 2.7A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS3157NT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>
 <p><b>NTJS3157NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p><b>NTJS3157N</b> ON ON SOT-23-6</p>	 <p><b>NTJS3151PT1</b> ON ON SOT363</p>	 <p><b>NTJS3151PT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 2.7A SOT-363</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ 0603YC102M4T4A	↔ 08055A620GAT2A	⇒ 90MT160MT	D AA80A-300L-015S-C	⇒ AD7547KNZ
⊖ AP8822C-28PI	⊕ BC847B-S4032R	D C2012X7R2A223K125AE	⇒ CL21B103KC6WPNC	⇒ CMPZ5223B
⊕ FS35R12W1T4ENG	⊖ GRM0225C1E3R6CA03L	⊕ GRM0336S1E510JD01D	↔ HSDL-3220-021	⇒ IRF9610PBF
D IRFH7923TRPBF	⊕ LM3151MHE-3.3	⊖ LM8262MMX/NOPB	⊕ LT1158CSW#PBF	⇒ NT6631A-CM121-EPEC
⇒ NTJD1155LT1G	↔ NTJD2152PT1	⊕ NTJD2152PT1G	⊖ NTJD3115PT1G	⇒ NTJD3158CT1G
↔ NTJD3158CT2G	⇒ NTJD4001NT1G	D NTJD4001NT2G	⊕ NTJD4105CT1G	⊖ NTJD4105CT2G
⊕ NTJD4152PT1	D NTJD4152PT1G	⇒ NTJD4158CT1G	↔ NTJD4158CT2G	⇒ NTJD4401NT1
⊖ NTJD4401NT1G	⊕ NTJD4401NT2	↔ NTJD5121NT1G	⇒ NTJD5121NT2G	⇒ NTJS3151PT1G
⊕ NTJS4151PT1G	⊖ NTJS4160NT1G	⊕ NTJS4405NT1G	D NTJS4405NT4G	⇒ NTJS4405UT1
↔ P086CH04	⊕ SAFEL881MFL0F00R	⊖ SS16-E3/61T	⊕ TLV2362CDR	⇒ VI-J53-EW

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited